

**ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ФАЗ
В СИСТЕМЕ MoSi₂-W В УСЛОВИЯХ НАГРЕВА
ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 1500—1800 °C**

П. И. Глушко, А. Ю. Журавлёв, Н. А. Семёнов, Н. А. Хованский,

Б. М. Широков, А. В. Шиян, В. В. Щербакова

*Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»,
Харьков, Украина*

Поступила в редакцию 22. 04. 2014

Исследована кинетика перераспределения фаз в системе MoSi₂-W при 1500—1800 °C. Определены кинетические параметры роста низших силицидов (Mo, W)₅Si₃ и уменьшение слоя высшего силицида MoSi₂ в зависимости от температуры окисления. Установлено, что стабильность системы MoSi₂-W превышает стабильность систем MoSi₂-Mo и WSi₂-W.

Ключевые слова: покрытие, силицид, диффузия, жаростойкость, вольфрам, молибден, ниобий, кремний.

**ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ УТВОРЮВАННЯ ФАЗ
У СИСТЕМІ MoSi₂-W В УМОВАХ НАГРІВАННЯ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 1500—1800 °C**

**П. І. Глушко, О. Ю. Журавльов, М. О. Семенов, М. О. Хованський,
Б. М. Широков, О. В. Шиян, В. В. Щербакова**

Досліджено кінетику перерозподілу фаз у системі MoSi₂-W при 1500—1800 °C. Визначено кінетичні параметри росту нижчих силіцидів (Mo, W)₅Si₃ і зменшення шару вищого силіциду MoSi₂ залежно від температури окислення. Встановлено, що стабільність системи MoSi₂-W перевищує стабільність систем MoSi₂-Mo і WSi₂-W.

Ключові слова: покриття, силіцид, дифузія, жаростійкість, вольфрам, молібден, ніобій, кремній.

**THE KINETICS OF PHASE
FORMATION IN SYSTEM MoSi₂-W UNDER HEATING
AT TEMPERATURE 1500—1800 °C**

**P. I. Glushko, A. Yu. Zhuravlyov, N. A. Semenov, N. A. Khovanski,
B. M. Shirokov, A. V. Shiyan, V. V. Shcherbakova**

The kinetics of phase redistribution in the MoSi₂-W system has been investigated in the temperature range 1500—1800 °C. Kinetic parameters for growth of low silicides (Mo, W)₅Si₃ and loss of the highest silicide MoSi₂ were determined depending on the temperature of oxidation. It is that stability of multicomponent and multiphase systems MoSi₂-W exceeds stability system MoSi₂-Mo and WSi₂-W.

Keywords: coating, silicide, diffusion, heat resistance, tungsten, molybdenum, niobium, silicon.

Успешное использование тугоплавких металлов в конструкциях для работы в высокотемпературных окислительно-восстановительных средах при температурах превышающих 1500 °C, остаётся актуальным и в настоящее время, в частности, для ракетно-космической, авиационной техники, атомной энергетики и других отраслей. Успех в этом направлении в значительной степени зависит

от решений, связанных с разработкой надёжных защитных покрытий.

Достойное место среди применяемых покрытий занимают силициды тугоплавких металлов. Известно, что высокотемпературному окислению в воздушной атмосфере лучше всего противостоят силициды молибдена, так как защитные покрытия из них наиболее жаростойкие.

В работах [1—3] приведены результаты исследований по стабильности и кинетике перераспределения фаз в системах WSi_2 -W, MoSi_2 -Mo, $(\text{MoW})\text{Si}_2$ -Nb. Под стабильностью подразумевается скорость распада силицидных покрытий в зависимости от времени нагрева образцов на воздухе при различных температурах. Поэтому для повышения стабильности покрытий, необходимо уменьшить скорость взаимодействия их с материалом основы. Анализ работ [1—3] показал, что наиболее высокой стабильностью обладают системы из многокомпонентных и многофазных барьерных слоёв из низших силицидов. Однако, несмотря на достаточно высокую жаростойкость силицидов вольфрама в области температур 1500—2000 °C, они обладают сравнительно низкой стойкостью при температурах ~1000 °C, где проявляется так называемая «чума» [3].

В этой связи были проведены исследования по изучению стабильности фаз в системе MoSi_2 -W, где явление «чумы» практически не проявляется. Изучалась возможность получения барьерных слоёв из силицидов $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ в системе MoSi_2 -W, а также их стабильность при нагреве в интервале температур 1500—1800 °C.

Осаждение металлических слоёв из тугоплавких металлов проводили в установке, схема которой приведена на рис. 1.

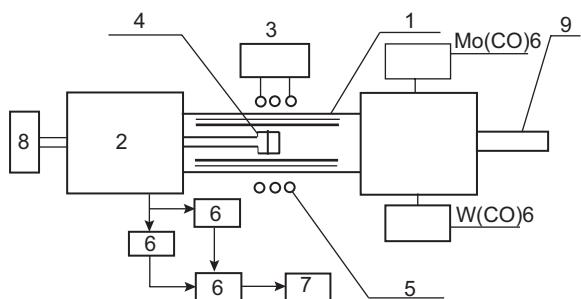


Рис. 1. Схема установки для осаждения W и Mo из карбонилов. 1 — реакционная камера, 2 — форкамеры, 3 — ВЧ-генератор, 4 — образцы, 5 — индуктор, 6 — азотные ловушки, 7 — форнасос, 8 — источник питания нагревателя, 9 — смотровое окно

Установка представляет собой аппарат проточного типа с горизонтальным расположением реактора и с ВЧ-нагревом металлических подложек с помощью высокочастотного генератора. Дополнительно

можно было нагревать образец прямым пропусканием тока. Реактор выполнен в виде трубы из кварцевого стекла с наружным диаметром 150 мм и длиной 600 мм. Внутри трубы коаксиально установлена медная щелевая водоохлаждаемая камера для защиты кварцевой трубы от перегрева.

В качестве образцов для проведения исследований использовали прутки вольфрама Ø 2 мм и длиной 80 мм, на которые путём термического разложения карбонила молибдена при температурах 800 °C наносился слой молибдена толщиной ~40—45 мкм. Затем образцы силицировали при остаточном давлении $1,33 \cdot 10^{-3}$ Па при температуре 1250 °C в течение 7 часов.

Испытания образцов проводились в атмосфере воздуха в интервале температур 1500—1800 °C в течение 30 часов на стенде (рис. 2). Нагрев осуществлялся прямым пропусканием тока.

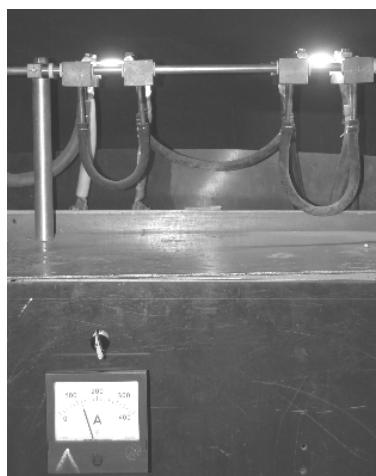


Рис. 2. Стенд для испытания образцов с силицидным покрытием

На рис. 3 приведены кинетические кривые распада фазы MoSi_2 для системы MoSi_2 -W. Диффузия кремния в низших силицидах происходит медленнее, чем в высших, что связано с меньшей концентрацией узлов кремниевой подрешётки и более прочными межатомными связями в фазах Me_5Si_3 . С ростом межатомных связей в структурно-однотипных силицидах коэффициент диффузии кремния в W_5Si_3 меньше, чем в Mo_5Si_3 . Это увеличивает диффузионное сопротивление X/D_2 (где X — толщина слоя низшего силицида, а D_2 — коэффициент диффузии кремния в низших силицидах) и

существенно повышает стабильность системы по сравнению с системами $\text{WSi}_2\text{-W}$ и $\text{MoSi}_2\text{-Mo}$ при тех же условиях отжига.

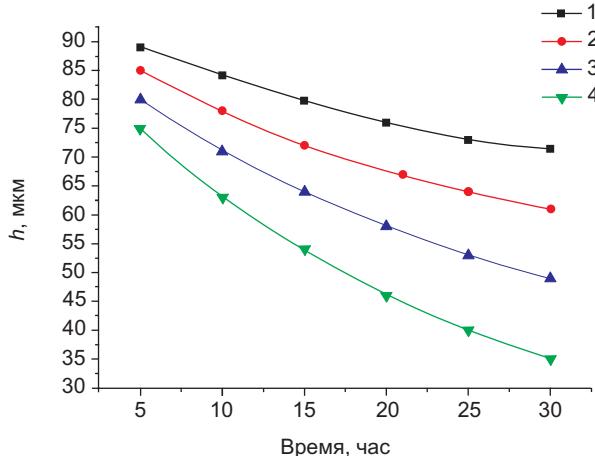


Рис. 3. Зависимость скорости распада MoSi_2 от времени нагрева. 1 — 1500 °C; 2 — 1600 °C; 3 — 1700 °C; 4 — 1800 °C

При распаде дисилицида молибдена в результате обменной реакции между молибденом и вольфрамом на межфазной границе MoSi_2 — W_5Si_3 образуется новая фаза $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$, представляющая собой твёрдый раствор низших силицидов молибдена и вольфрама.

На рис. 4 приведены кинетические кривые роста фазы $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ от времени в интервале 1500—1800 °C.

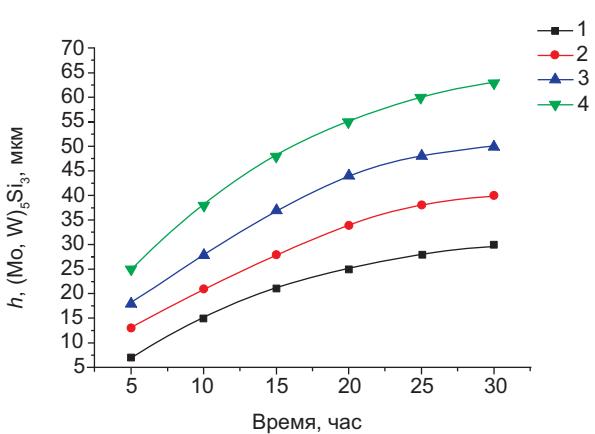


Рис. 4. Зависимость скорости роста фазы $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ от времени нагрева. 1 — 1500 °C; 2 — 1600 °C; 3 — 1700 °C; 4 — 1800 °C

С повышением температуры скорость роста возрастает. Для выяснения полной картины роста фаз низшего силицида, построены кривые роста фазы $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ от

времени в логарифмических координатах (рис. 5).

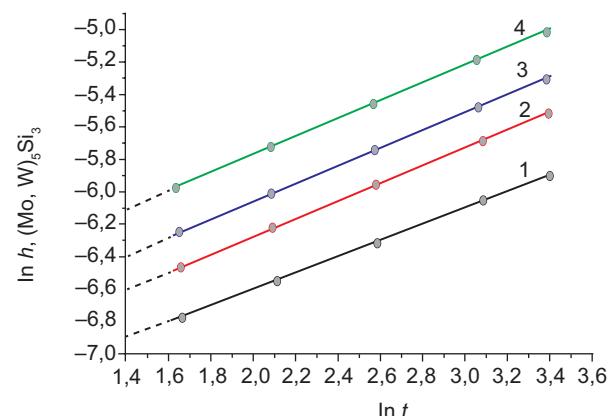


Рис. 5. Рост фазы $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ в системе $\text{MoSi}_2\text{-W}$ при 1 — 1500 °C; 2 — 1600 °C; 3 — 1700 °C; 4 — 1800 °C

Анализ кинетических кривых роста фазы $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ показал, что увеличение толщины слоя описывается параболическим законом. Показатель степени n в уравнении $h^n = k_0 t$ (где h — толщина слоя, t — время, k_0 — константа роста слоя) равен 2.

Проведенные эксперименты показали, что за 3 часа отжига на воздухе при 1700 °C в системе $\text{MoSi}_2\text{-Mo}$ толщиной 80 мкм полностью превращается в Mo_5Si_3 , а в системе $\text{MoSi}_2\text{-W}$ из 80 мкм слоя MoSi_2 осталось 15 мкм, при этих же условиях в системе $\text{MoSi}_2\text{-W}$ в низшую фазу $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ превращается 5—7 мкм исходного слоя $\text{MoSi}_2\text{-W}$. Уменьшение скорости распада в многокомпонентной системе $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3\text{-W}$ обусловлено увеличением диффузационного сопротивления за счёт многофазности образующейся при нагреве системы.

На рис. 6 приведено распределение концентраций молибдена, вольфрама и кремния по толщине покрытия в образце, испытанном при температуре 1700 °C в течение 25 часов. Данные получены с помощью растрового электронного микроскопа РЭМА-200.

Проведенные исследования поверхности роста образцов силицидных покрытий показали, что их характерной особенностью является практически полное отсутствие трещин (рис. 7).

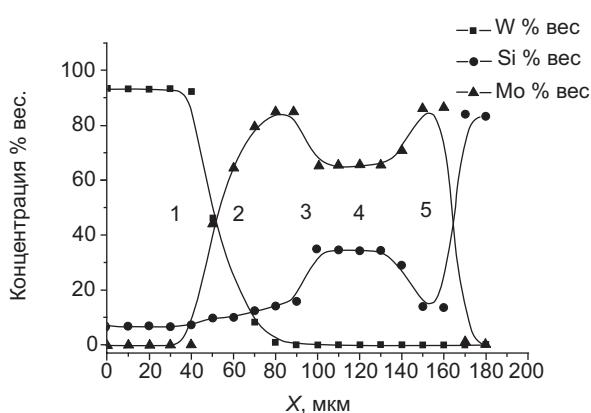


Рис. 6. Распределение элементов по толщине покрытия MoSi_2 на вольфраме после отжига при $1700\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 25 ч. Отсчет толщины покрытия производился от границы с вольфрамом. 1 — W_5Si_3 ; 2 — $(\text{W}, \text{Mo})_5\text{Si}_3$; 3 — Mo_5Si_3 ; 4 — MoSi_2 ; 5 — Mo_5Si_3

Температурная зависимость константы скорости роста фазы $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ описывается экспоненциальным законом: $k = 10^{-3}e^{-40000/T}$.

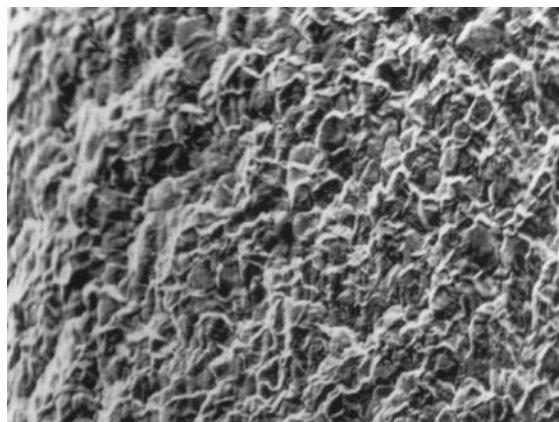


Рис. 7. Морфология поверхности силицидного покрытия, $x 500$

На рис. 8 приведена зависимость константы скорости роста фазы $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ от $1/T$.

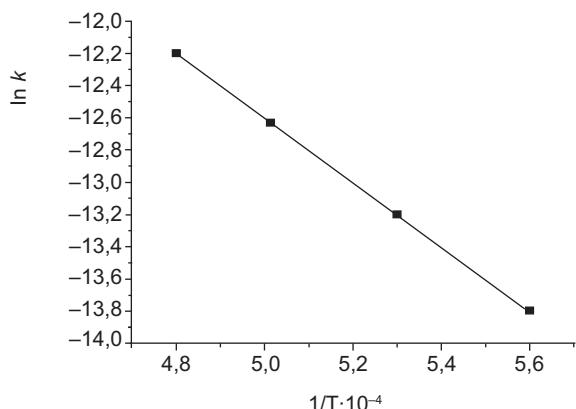


Рис. 8 Зависимость логарифма константы скорости роста фазы $(\text{Mo}, \text{W})_5\text{Si}_3$ от $1/T$

Таким образом, выполненные исследования показывают, что стабильность системы MoSi_2 -W значительно превышает стабильность систем MoSi_2 -Mo и WSi_2 -W.

ЛИТЕРАТУРА

1. Змий В. И., Ковтун Н. В., Глушко П. И., Руденький С. Г. Стабильность и жаростойкость силицидных покрытий на вольфраме и молибдене при температурах 1500 — $2000\text{ }^{\circ}\text{C}$ // Порошковая металлургия. — 2003. — № 1/2. — С. 57—62.
2. Глушко П. И., Змий В. И., Семёнов Н. А., Широков Б. М. Стабильность силицидных покрытий на ниобии в условиях высокотемпературного нагрева на воздухе при 1500 — $2000\text{ }^{\circ}\text{C}$ // Порошковая металлургия. — 2003. — № 3/4. — С. 55—59.
3. Нечипоренко Е. П., Петриченко А. П., Павленко Ю. Б. Защита металлов от коррозии // «Вища школа». — Харьков, 1985. — С. 112.

LITERATURA

1. Zmij V. I., Kovtun N. V., Glushko P. I., Ruden'kij S. G. Stabil'nost' i zharostojkost' siliqidnyh pokrytij na vol'frame i molibdene pri temperaturah 1500 — $2000\text{ }^{\circ}\text{C}$ // Poroshkovaya metallurgiya. — 2003. — No. 1/2. — P. 57—62.
2. Glushko P. I., Zmij V. I., Semenov N. A., Shirokov B. M. Stabil'nost' silicidnyh pokrytij na niobii v usloviyah visokotemperaturnogo нагрева na vozduhe pri 1500 — $2000\text{ }^{\circ}\text{C}$ // Poroshkovaya metallurgiya. — 2003. — No. 3/4. — P. 55—59.
3. Nechiporenko E. P., Petrichenko A. P., Pavlenko Yu. B. Zaschita metallov ot korrozii // «Vischa shkola». — Har'kov, 1985. — P. 112.